CLIPPEDIMAGE= JP402221962A

PAT-NO: JP402221962A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 02221962 A

TITLE: RESIST DEVELOPER

PUBN-DATE: September 4, 1990

INVENTOR - INFORMATION:

NAME

SAMEJIMA, SHUNICHI

KITAMURA, TATEO

WATANABE, NAOHIRO

ASANO, AKIO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

ASAHI GLASS CO LTD

COUNTRY

N/A

APPL-NO: JP01041853

APPL-DATE: February 23, 1989

INT-CL (IPC): G03F007/32; H01L021/027

US-CL-CURRENT: 430/325

ABSTRACT:

PURPOSE: To improve development of a resist by mixing a 3C

unsaturated

chlorofluorohydrocarbon with a developer.

CONSTITUTION: The resist developer contains as an effective component a 3C

unsaturated chlorofluorohydrocarbon (A), embodied by

1-chloro-2-fluoropropene,

2,3-dichloro-3,3-difluoropropene, or

1,1-dichloro-3,3,3-trifluoropropene, and

the like, and in addition, preferably, hydrocarbons,

alcohols, ketones, and the

like when needed.

COPYRIGHT: (C) 1990, JPO&Japio

06/28/2002, EAST Version: 1.03.0002

⑩日本国特許庁(JP)

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-221962

®Int. Cl.⁵

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)9月4日

G 03 F 7/32 H 01 L 21/027 7124-2H

7376-5F H 01 L 21/30 3 6 1

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全4頁)

60発明の名称 レジスト現像剤

②特 願 平1-41853

20出 頤 平1(1989)2月23日

@発明者 鮫島 俊一 東京都中野区中央2-49-15

20発明者 北村 健郎 神奈川県藤沢市鵠沼桜が岡2-7-24

の発 明 者 渡 辺 直 洋 千葉県千葉市都賀の台 1 -26-2

@発 明 者 浅 野 昭 雄 神奈川県横浜市神奈川区三枚町543

⑪出 願 人 旭 硝 子 株 式 会 社 東京都千代田区丸の内 2丁目 1番 2号

@代理人 弁理士 栂村 繁郎 外1名

明超書

1. 発明の名称

レジスト現像剤

2. 特許請求の範囲

- 1、 炭素数が3である不飽和塩素化弗素化炭化 水素を有効成分として含有するレジスト現像剤。
- 2、不飽和塩業化弗索化炭化水紫が 1-クロロ-2-フルオロプロペン、2,3-ジクロロ-3,3-ジフルオロプロペン、1,1-ジクロロ-3,3,3-トリフルオロプロペン、1,2-ジクロロ-3,3,3-トリフルオロプロペン、1,3-ジクロロ-1,3,3-トリフルオロプロペン、1,3-ジクロロ-2,3,3-トリフルオロプロペン、3,3-ジクロロ-1,1,3-トリフルオロプロペン、3,3-ジクロロ-2,3-ジフルオロプロペンである請求項1に記載のレジスト現像剤。
- 3、レジスト現像剤中に、炭化水素類、アルコール類、ケトン類、ハロゲン化炭化水素類、叉はエステル類から選ばれる少なくとも1種が含まれている請求項1に記載のレジスト現像剤。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、プリント基板や半導体の製造時にレジストを現像するために用いるレジスト現像剤に関するものである。

「従来の技術」

プリント基板や半導体回路を作成する場合レジスト生布、露光に続いてレジストを現像し、次いで、エッチングする工程があるが、このレジストを現像するために、従来1,1,1-トリクロロエタン、モノクロロベンゼン等の塩素系レジスト現像剤やメチルイソブチルケトン等のケトン系レジスト現像剤等が使われている。

[発明が解決しようとする課題]

従来使用されていた塩素系レジスト現像剤が地下水汚染の点から好ましくないため、その使用量を抑制する必要がある。 叉、ケトン系レジスト現像剤は、可燃性であり設備の防爆化が必要である等の問題がある。 本発明は、これらの問題に対応し、新規のレジスト現像剤を提供することを目的とするものである。

・[課題を解決するための手段]

本発明は前述の目的を達成すべくなされたもの であり、炭素数が3である不飽和塩素化弗素化炭 化水素を有効成分として含有するレジスト現像剤 を提供するものである。 本発明の不飽和塩素化弗 素化炭化水素としては、1-クロロ-2-フルオロプロ ペン (b.p. 59℃)、 2.3-ジクロロ-3.3-ジフルオ ロプロペン(b.p.57℃)、1,1-ジクロロ-3,3,3-ト リフルオロプロペン(b.p.54℃)、 1.2-ジクロ ロ-3.3.3-トリフルオロプロペン(b.p.53℃)、 1.3-ジクロロ-1.3.3-トリフルオロアロペン(b. p. 57℃)、1.3-ジクロロ-2.3.3-トリフルオロプロ ペン (b.p.67℃)、3.3-ジクロロ-1,1,3-トリフル オロプロペン (b.p.52℃)、3,3-ジクロロ-2,3-ジ フルオロプロペン (b.p.54℃) 等の含水素不飽和 塩素化弗素化炭化水素から選ばれる1種叉は2種 以上の混合物が好ましい。

本発明のレジスト現像剤には、各種の目的に応 じてその他の各種成分を含有させることができる。 例えば、さらに良好に現像するために、炭化水素

ルペンタン、2.2.3-トリメチルペンタン、イソオクタン、ノナン、2.2.5-トリメチルヘキサン、デカン、ドデカン、1-ペンテン、2-ペンテン、1-ヘキセン、1-オクテン、1-ノネン、1-デセン、シクロペンタン、メチルシクロペンタン、シクロペキサン、エチルシクロヘキサン、ビシクロヘキサン、エチルシクロヘキセン、アミルナフタレン等から選ばれるものである。より好ましくはn-ペンタン、ネオヘキサン、2.3-ジメチルブタン、n-ヘギタン等である。

アルコール類としては、炭素数 1~17の鎖状 又は、現状の飽和又は不飽和アルコール類が好ま しく、メタノール、エタノール、n-アロピルアル コール、イソプロピルアルコール、ローブチルアル コール、イソブチルアルコール、sec-ブチルアル コール、tert-ブチルアルコール、ペンチルアルコ ール、sec-アミルアルコール、1-エチル-1-アロバ ノール、2-メチル-1-ブタノール、イソペンチルア 類、アルコール類、ケトン類、ハロゲン化炭化水 索類叉はエステル類等の有機溶剤から選ばれる少 なくとも1種を含有させることができる。これら の有機溶剤のレジスト現像剤中の含有剤合は、 0 ~50重量%、好ましくは10~40重量%、さ らに好ましくは20~30重量%である。本発明 の塩素化弗素化炭化水素類と有機溶剤との混合物 に共沸組成が存在する場合には、その共沸組成で の使用が好ましい。

世化水素類としては、炭素数 1 ~ 1 5 の直鎖叉は環状の飽和叉は不飽和炭化水素類が好ましく、n-ペンタン、イソペンタン、n-ヘキサン、イソヘキサン、ネオヘキサン、2.3-ジメチルブタン、3-メチルペンタン、n-ヘアタン、イソヘアタン、3-メチルヘキサン、2.4-ジメチルヘキサン、2.5-ジメチルヘアタン、2.2-ジメチルヘキサン、2.5-ジメチルヘキサン、3.3-ジメチルヘキサン、2-メチル-3-エチルペンタン、2.3.4-トリメチ

ルコール、tert-ペンチルアルコール、3-メチル-2-ブタノール、ネオペンチルアルコール、1-ヘキ サノール、2-メチル-1-ペンタノール、4-メチル-2-ペンタノール、2-エチル-1-ブタノール、1-ヘア タノール、2-ヘアタノール、3-ヘアタノール、1-オクタノール、2-オクタノール、2-エチル-1-ヘキ サノール、1-ノナノール、3.5.5-トリメチル-1-ヘ キサノール、1-デカノール、1-ウンデカノール、 1-ドデカノール、アリルアルコール、アロパルギ ルアルコール、ベンジルアルコール、シクロヘキ サノール、1-メチルシクロヘキサノール、2-メチ ルシクロヘキサノール、3-メチルシクロヘキサノ ール、4-メチルシクロヘキサノール、α-テルヒネ オール、アビエチノール、2,6-ジメチル-4-ヘアタ ノール、トリメチルノニルアルコール、テトラデ シルアルコール、ヘアタデシルアルコール等から 選ばれるものである。 より好ましくは、 メタノー ル、エタノール、イソプロピルアルコール等であ

ケトン類としては、R-CO-R'.

R-CO-R'-CO-R".

R - CO - R'(ここで、R、R'、R''は炭素数 1~9の飽和叉は不飽和炭化水素基)のいずれか の一級式で示されるものが好ましく、 アセトン、 メチルエチルケトン、2-ペンタノン、3-ペンタノ ン、2-ヘキサノン、メチルブチルケトン、メチル イソブチルケトン、2-ヘアタノン、4-ヘアタノン、 ジィソプチルケトン、アセトニルアセトン、メシ チルオキシド、ホロン、メチル-ロ-アミルケトン、 エチルブチルケトン、メチルヘキシルケトン、シ クロヘキサノン、メチルシクロヘキサノン、イソ・ ホロン、2,4-ペンタンジオン、ジアセトンアルコ ール、アセトフェノン、フェンチョン等から選ば れるものである。 より好ましくは、 アセトン、 メ チルエチルケトン、メチルブチルケトン、メチル イソブチルケトン、シクロヘキサノン等である。

ハロゲン化炭化水素類としては、炭素数1~4 の飽和叉は不飽和のハロゲン化炭化水素類が好ま しく、ジクロロメタン、 四塩化炭素、 クロロホル ム、1.1-ジクロロエタン、1.2-ジグロロエタン、 1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタ ン、1,1,1,2-テトラクロロエタン、1,1,2,2-テト ラクロロエタン、ペンタクロロエタン、1.1-ジク ロロエチレン、trans-1.2-ジクロロエチレン、ci s-1, 2-ジクロロエチレン、トリクロロエチレン、 テトラクロロエチレン、1-クロロプロパン、2-ク ロロプロパン、モノクロロベンゼン、ジクロロベ ンゼン、1-ブロモアロパン、2-ブロモアロパン等 から選ばれるものである。 より好ましくは、 ジク ロロメタン、1.1.1-トリクロロエタン、 trans-1. 2-ジクロロエチレン、 cis-1,2-ジクロロエチレン、 トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、モ ノクロロベンゼン、2-ブロモプロパン等である.

エステル類としては、次の一般式で示されるも のが好ましく、 Ri-COO-Rax

 $R_1-C_0O-R_2-C_0O-R_3$, (COOR₁) 2,

Ø-COOR, ĊOOR2

(ここで、R1、R2、R2、R4、R5、R0はH叉 は炭素数1~19の飽和ないし、不飽和結合を有 する炭化水素基)。

具体的には、蟻酸メチル、蟻酸エチル、蟻酸ア ロピル、 蟻酸ブチル、 蟻酸イソブチル、 蟻酸ペン チル、酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸プロピル、

酢酸イソプロピル、酢酸ブチル、酢酸イソブチル、 酢酸sec-ブチル、酢酸ペンチル、酢酸イソペンチ ル、2-メトキシメチルアセテート、2-メトキシエ チルアセテート、3-メトキシブチルアセテート、 酢酸sec-ヘキシル、2-エチルプチルアセテート、 2-エチルヘキシルアセテート、酢酸シクロヘキシ ル、酢酸ペンジル、プロピオン酸メチル、プロピ オン酸エチル、プロピオン酸ブチル、プロピオン 酸イソペンチル、酪酸メチル、酪酸エチル、酪酸 ブチル、 酪酸イソペンチル、イソ酪酸イソブチル、 2-ヒドロキシ-2-メチルアロピオン酸エチル、ステ アリン酸プチル、ステアリン酸ペンチル、安息香 酸メチル、安息香酸エチル、安息香酸プロピル、 安息香酸ブチル、 安息香酸イソペンチル、 安息香 酸ペンジル、アピエチン酸エチル、アピエチン酸 ベンジル、アジピン酸ピス-2-エチルヘキシル、ァ -ブチロラクト、シュウ酸ジエチル、シュウ酸ジブ チル、シュウ酸ジペンチル、マロン酸ジエチル、 マレイン酸ジメチル、マレイン酸ジエチル、マレ イン酸ジブチル、酒石酸ジブチル、クエン酸トリ

. ブチル、セバシン酸ジブチル、セバシン酸ビス-2 -エチル、フタル酸ジメチル、フタル酸ジエチル、 フタル酸ジブチル、フタル酸ビス-2-エチルヘキシ ル、フタル酸ジオクチル等から選ばれるものであ る。より好ましくは、酢酸メチル、酢酸エチル、 酢酸プロピル、酢酸イソプロピル、酢酸ブチル、 酢酸イソブチル、酢酸sec-ブチル、酢酸ペンチル、 酢酸イソペンチル、2-メトキシメチルアセテート、 2-メトキシエチルアセテート等である。

本発明により現像し得るレジストとしては、何 ち限定されず、ボジ型叉はネガ型のフォトレジス ト、 選業外線レジスト、 X線叉は電子線レジスト 等を挙げることができる。

フォトレジストの材質には、ドライフィルムレジスト用のアクリル系、フェノール及びクレゾールノボラック樹脂をベースにしたキノンジアジド系、シス-1.4-ボリイソプレンを主成分とする環化ゴム系、ボリケイ皮酸系等があり、選集外線レジストには、ボリメチルメタクリレート、ボリメチルイソプロペニルケトン等があり、電子線、X級

レジストには、ポリメチルメタクリレート、メタ クリル酸グリシジルーアクリル酸エチル共重合体 等が知られているが、本発明のレジスト現像剤は いずれにも有効である。

レジスト現像方法も何ら限定されず、通常のス プレー法、浸漬法等を採用することができる。

[実施例]

奥施例1~13

下記第1表に示すレジスト現像剤を用いてレジスト現像試験を行なった。ドライフィルムレジスト(Laminer、ダイナケム社製)をラミネートした網環積層板に100μmライン&スペースのテストパターンを露光後、レジスト現像剤で現像し、パターンが形成されているか、叉スペース部に残渣がないかを顕微鏡にて観察した。その結果を第1表に示す。

第1表

	レジスト現像剤	视察結果
実施例1	1-プロロー2-7/4ロアロペ・ン(100)	0
実施例2	2, 3-ジ クロロー3, 3-ジ アルオロプロペン(100)	0
実施例3	1. 1ージ クロロー3, 3, 3ートリフルオロア ロヘ・ン(100)	•
実施例4	1, 2–5° ታመ–3, 3, 3–ኑሃፖቤተወፖ ወላ° ኦ(100)	©
実施例5	1, 3–ジ ク፡፡፡፡1, 3, 3–トリフルオᡃᡆፖ ፡፡ペン(100)	0
実施例6	1. 3-ቻ ኃ ፡፡፡-2, 3, 3-ት <i>ዛንቤ</i> ተወፖ ወላ° ኦ(100)	0
実施例7	3, 3-ジク፡፡፡-1, 1, 3-トリフルネロፓ ፡፡ペン(100)	•
実施例8	3, 3-ቻ ንመ-2, 3-ቻ ንሉመፖ ውላ ን(100)	0
実施例9	3, 3-ジ プロロー1, 1, 3-トリアルオロンア゙ロペン(90)/	0
実施例10	デカペンガン(10) 3.3-ジクロロー1, 1, 3-トリアルオロプロペン(90) /	0
実施例11	ብሃሮ ወቲ * ለፖለታ-ሐ (10) 3, 3-ቻ 7፡፡፡0−1, 1, 3-ትሃፖለቱወፖ ካላ ' ン (80) /	0
実施例12	メキルイソブ キルナトン(20) 3,3-ジ クロロー1,1,3-トリフルオロブ ロペン(70)/	0
実施例13	1, 1, 1-トリクロロエケン(30) 3, 3-ジ クロロー1, 1, 3-トリフルヤロブ ロペ*ン(75) / 酢酸ナミル(25)	Ö

().内は混合比 [重量%]

○:良好に現像できる△:やや不良

〇: ほぼ良好 ×: 不良

[発明の効果]

本発明のレジスト現像剤は、実施例から明らかなように現像効果の優れたものである。 叉、 従来使用されていた塩素系現像剤等に比べ、 プリント 基板に使われるプラスチック等に対し悪影響がほとんどない点も有利である。

代理人 母村緊部外1名